

Запрещается:

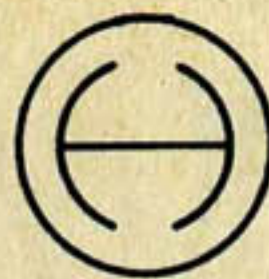
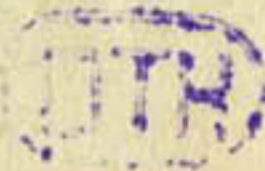
- эксплуатация микросхем после демонтажа;
- подавать какие-либо электрические сигналы на свободные выводы микросхемы;
- в режиме стирания подавать напряжение питания записи, напряжение смещения записи, напряжение смещения считывания;
- в режиме записи подавать напряжение смещения считывания;
- в режиме считывания подавать напряжение смещения записи и напряжение питания записи.

При эксплуатации рекомендуется соблюдение условий питания микросхемы: $U_{п.зп} = U_{см.зп} = U_{вх}$ (от одного источника питания); $U_{п.сч} = U_{к.ч} = U_{в.кр.сч} = U_{з.зп}$ (от одного источника питания); $|U_{вх.зп}| = |U_{вх.ст}|$.

Микросхема К5I9PEI соответствует техническим условиям ОК0.348.193 ТУ и признана годной для эксплуатации.

Дата выпуска

Место для
штампа ОТК



МИКРОСХЕМЫ К5I9PEI
ГОСТ 18725-73

Э Т И К Е Т К А

Полупроводниковая интегральная микросхема К5I9PEI - матрица-накопитель постоянных запоминающих устройств со схемами частичной дешифрации и электрической перезаписью информации. Информационная емкость 128 бит, число разрядов в информационном слове - 8.

Основное назначение: применение в радиоэлектронной аппаратуре широкого применения.

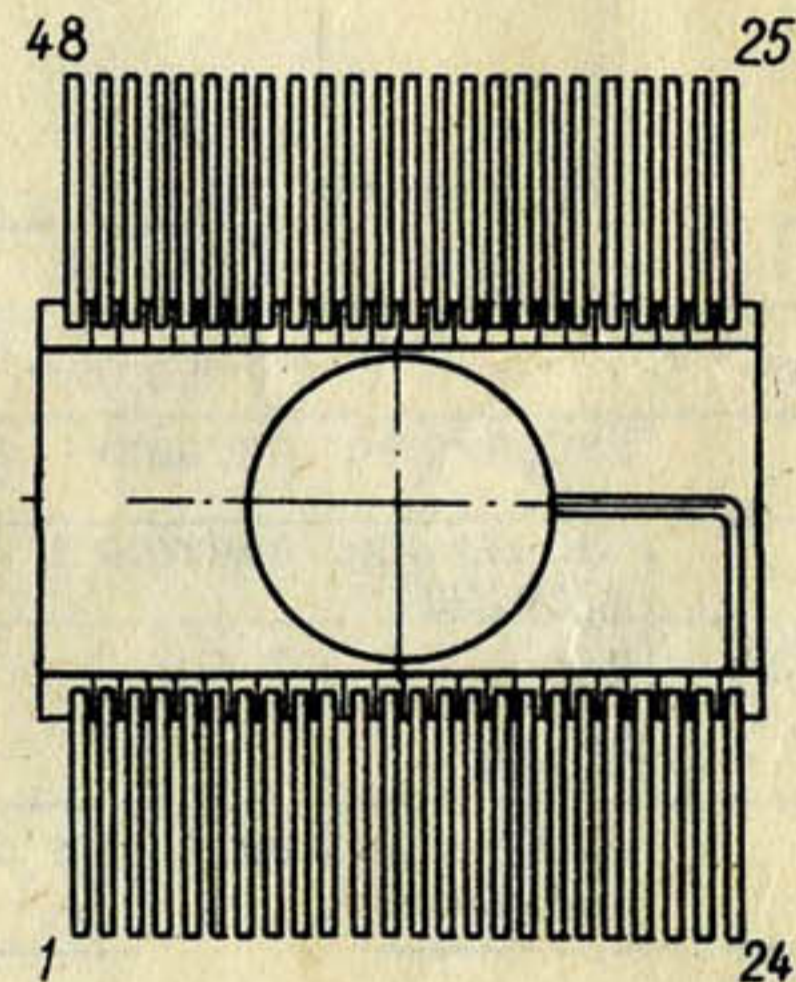
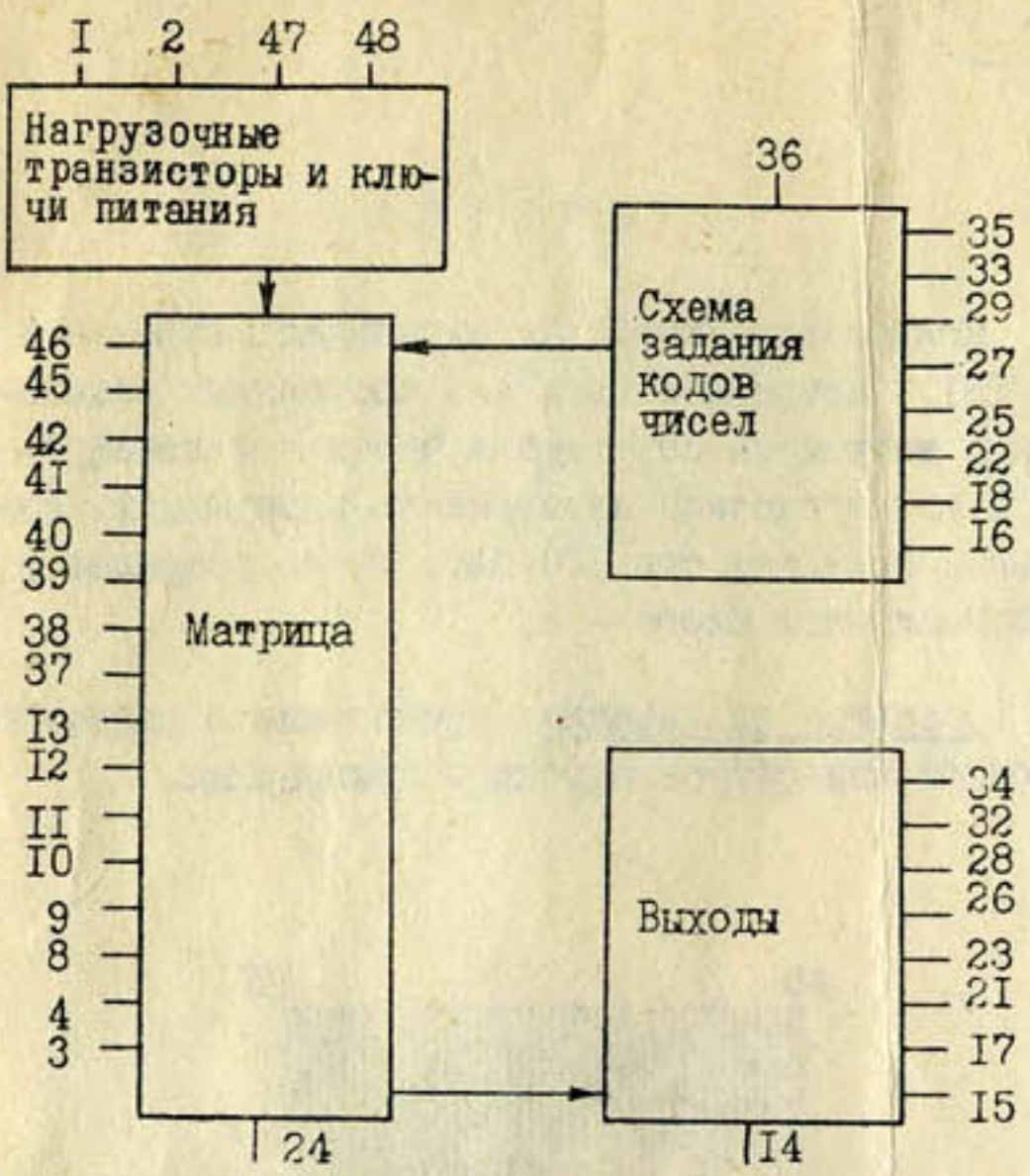


СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ



Контакт	Цепь
1	Напряжение питания записи (Uп.зп)
2	Напряжение смещения записи (Uсм.зп)
3, 46, 4, 45, 8, 42, 9, 41, 10, 40, 11, 39, 12, 38, 13, 37	Входы I...I6 (Uвх)
14	Выбор кристалла при считывании (Uв.кр.сч)
5, 6, 7, 19, 20, 30, 31, 43, 44	Свободные
15, 17, 21, 23, 26, 28, 32, 34	Выходы I...8 (Uвых)
16, 18, 22, 25, 27, 29, 33, 35	Коды чисел I...8 (Uк.ч)
24	Общий
36	Запрет записи (Uз.зп)
47	Напряжение питания считывания (Uп.сч)
48	Напряжение смещения считывания (Uсм.сч)

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ПРИ ПОСТАВКЕ

Наименование параметра	Норма	
	не менее	не более
Выходной ток логического нуля, I ⁰ вых, мкА	70	-
Выходной ток логической единицы, I ¹ вых, мкА	-	5
Время считывания, tсч, нс	-	250
Режим измерения: Uп.зп = Uсм.зп = Uк.ч = Uз.зп = 0В; Uсм.сч = -24 В; Uп.сч = = Uв.кр.сч = -9В; Uвх.А = -5 В		

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ДОПУСТИМЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ РЕЖИМОВ ЭКСПЛУАТАЦИИ*

Наименование параметра	Норма	
	не менее	не более
Напряжение питания записи, Uп.зп, В	-5I	-
Напряжение смещения записи, Uсм.зп, В	-5I	-
Напряжение питания считывания, Uп.сч, В	-I2	-
Напряжение смещения считыв., Uсм.сч, В	-28	-
Входное напряжение, В: в режиме записи, Uвх.зп в режиме стирания, Uвх.ст	-5I	-
Максимальная длительность импульса записи (стирания), τмах, нс	5	7

Содержание драгоценных металлов: "золото" 50,9346 мг, "серебро" 73,04 мг.

* В диапазоне температур от минус 45 до +55°С.

УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

При эксплуатации соблюдать меры предосторожности по защите микросхемы от воздействия статического электричества.

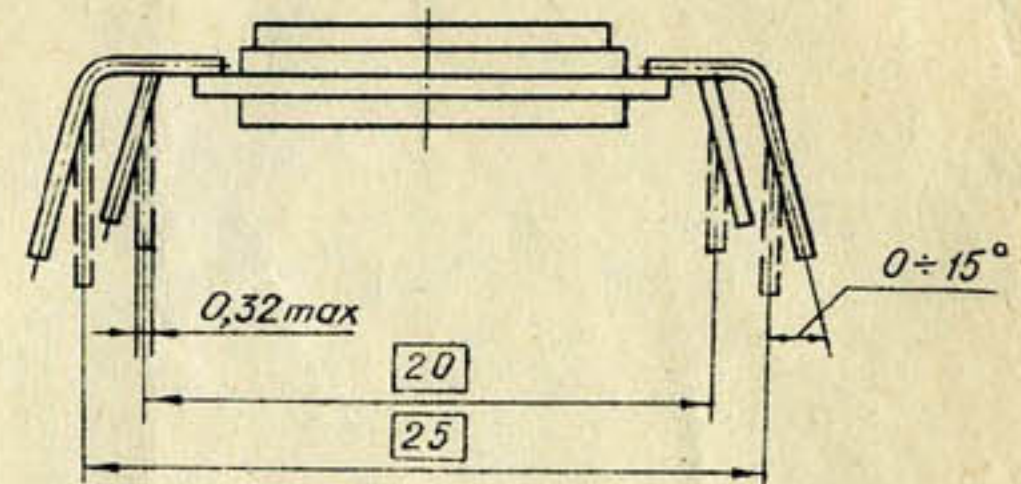
При транспортировании и хранении выводы микросхем должны быть закорочены между собой до момента установки в аппаратуру.

Работы с микросхемами должны производиться с соблюдением следующих условий:

- участки рабочих столов, стульев, пола, с которыми могут соприкасаться оператор или микросхемы, должны быть выполнены из материала с удельным поверхностным сопротивлением не более $1 \cdot 10^7$ Ом.м;
- работы с микросхемами должны выполняться оператором в антистатической одежде или с заземленным кольцом (браслетом) на руке;
- сопротивление электростатического заземления должно быть в пределах от 0,5 до 1,0 МОм.

Пайку микросхемы на плату производить с формованными выводами.

Формовка выводов микросхемы производится согласно рисунку:



Допускается однократная формовка. Формовочное устройство должно быть заземлено.

Установку микросхемы на плату в аппаратуре производить с зазором $0,7^{+0,3}$ мм от нижней плоскости основания.